

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

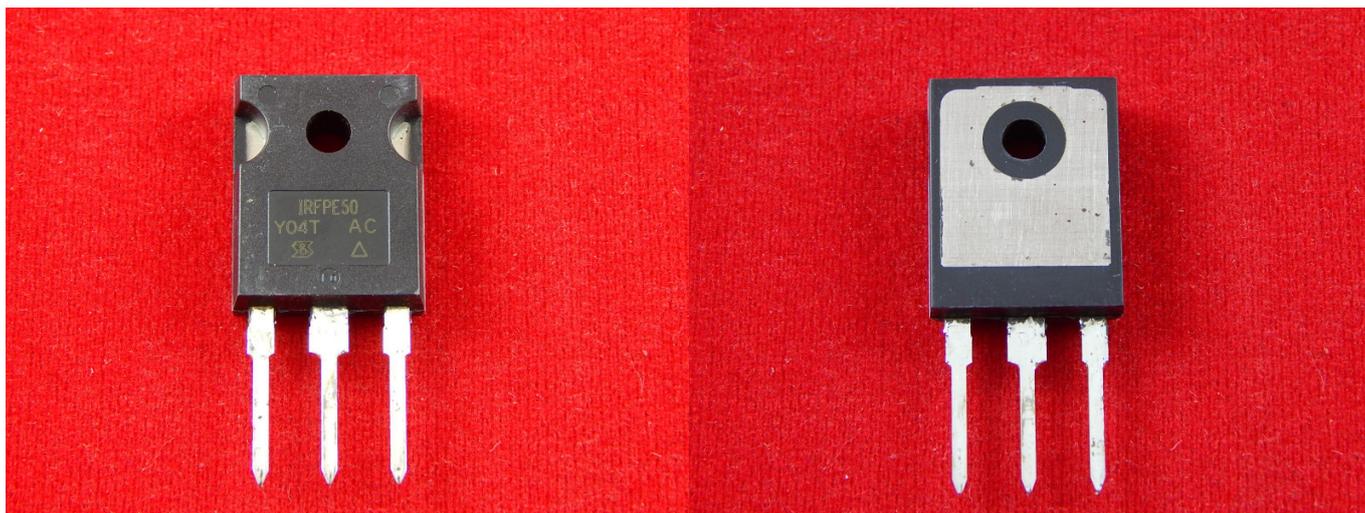
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15716

Цена в прайсе: 1574 тг.

Транзистор IRFPE50, N канальный, 800V, 7.8A, TO-247AC



Транзистор – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

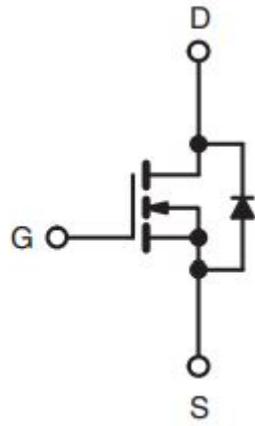
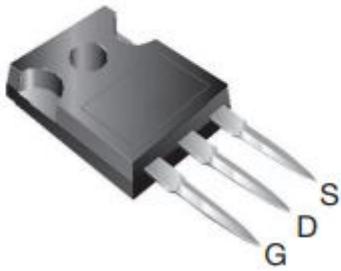
МОП-структура — полупроводниковая структура, применяемая при производстве микросхем и дискретных полевых транзисторов. Полупроводниковые приборы на основе этой структуры называют МОП-транзисторами, МДП-транзисторами или транзисторами с изолированным затвором.

Спецификация:

- Наименование прибора: IRFPE50;
- Тип транзистора: MOSFET;
- Полярность: N;
- Максимальная рассеиваемая мощность: 190 W;
- Предельно допустимое напряжение сток-исток: 800 V;
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток: 10 V;
- Пороговое напряжение включения: 4 V;
- Максимально допустимый постоянный ток стока: 7.8 A;
- Максимальная температура канала: 150 °C;
- Общий заряд затвора: 200 nC;
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора: 1.2 Ohm;
- Рабочая температура: от -55°C до +150°C.
- Тип корпуса: TO-247AC.

Структурная схема:

TO-247AC



N-Channel MOSFET